

关键技术指标及应用功能框图

最高频率：40MHz

电源电压：VDD=5V VCC=5V

输入信号：兼容 TTL

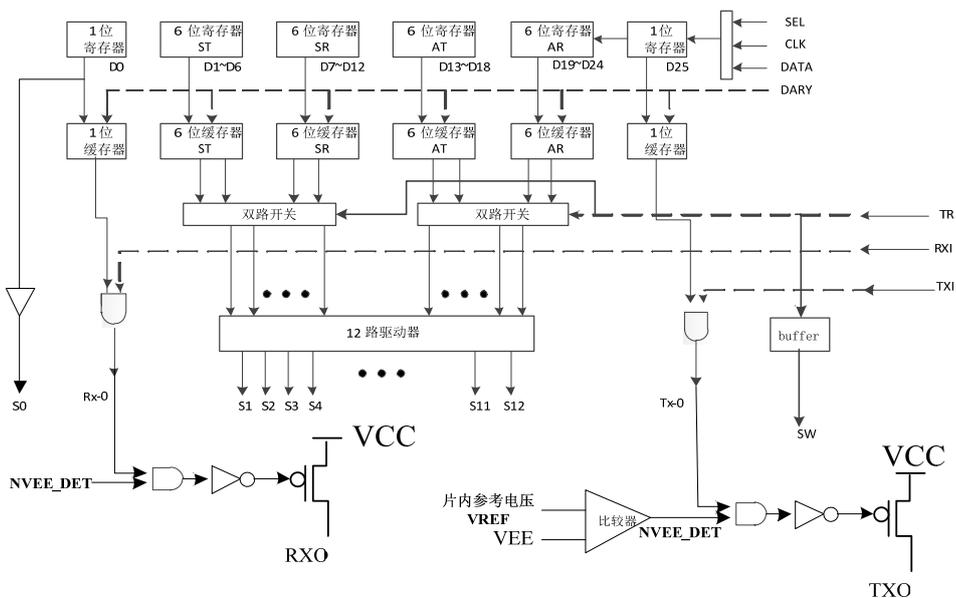
输出信号：0V~5V

上电态：上电后数字输出端 0V，电源开关 PMOS 管关断

外形尺寸：1mm×1.8mm×0.3mm

功能概述：

1. 实现串并转换，26bit 串行输入，D0, D25 参与对 RXO 和 TXO 进行控制，D<24:1>输出至 P1~P6、A1~A6 等控制位。其中对应关系当 TR 引脚为高电平时，P1~P6 对应 D1~D6，A1~A6 对应 D13~D18；当 TR 引脚为低电平时，P1~P6 对应 D7~D12，A1~A6 对应 D19~D24。D0 参与进行 RXO 的控制；D25 参与进行 TXO 的控制。
2. 集成负压电路检测功能，芯片接入-5V 的 VEE 电压，当 VEE 低于-3.5V 时，视为负压电路工作正常，可以开启 2 路 PMOS 管，即参与 RXO 和 TXO 的控制。
3. 集成 2 路 PMOS 控制开关，可分别驱动电流 400mA。PMOS 管电源为 VCC，输出分别使用 RXO 和 TXO 引脚。
4. 各数字输入支持 TTL 电平。当高于 2.4V 时，视为高电平，低于 0.4V 时，视为低电平。

芯片原理框图：

芯片原理框图

注：上图中 S1~S12 对应 P1~P6 以及 A1~A6，具体对应关系参见引脚说明。

产品简介

该串转并驱动器芯片采用 CMOS 工艺，内置 26 位串转并电路，可将 26 位串行 TTL 输入数据转换为并行的 26 位 TTL 输出信号，12 位输出信号 S1~S12 是由输入的第 1 位到第 24 位数据进行二选一后产生，其他输出信号为逻辑输出。该产品功耗低，使用方便，速度快等特点，可方便应用于控制 GaAs FET 开关、衰减器和移相器等电路。本产品具有上电清零功能。

允许绝对最大值 (T_A=25℃)¹

符号	参数	数值	备注
VDD	电压	6V	
Tstg	存储温度	-65~150℃	

【1】 超过以上任何一项最大限额都有可能造成永久损坏。

电性能参数 (T_A=25℃)

符号	参数	测试条件	数值			单位
			最小值	典型值	最大值	
I _{dd}	数字电源静态电流	VDD=5V	-	-	1	mA
F _{max}	最高工作频率		-	40	-	MHz
t _{PDARY}	DARY 上升沿至输出数据跳变时间	VCC=5V	-	10	-	ns
t _{PMOS}	PMOS 开关从 RXI 或 TXI 控制开关切换至 PMOS 输出建立至 4.5V 所用时间	VDD=5V VCC=5V VEE=-5V			25	ns